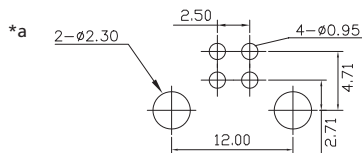
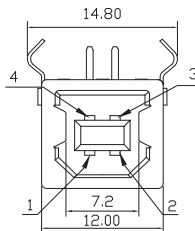
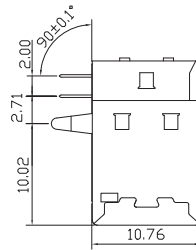
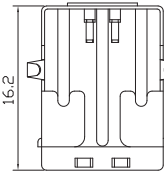
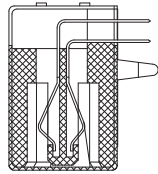
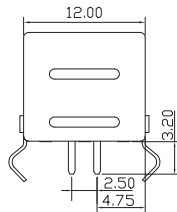




2411 02



2411 03



*a Leiterplattenlayout
printed circuit board layout
modèle de la carte imprimée

Bestellbezeichnung Designation Désignation	Polzahl Poles Pôles	Verpackungseinheit Package unit Unité d'emballage
2411 02	4	100
2411 03	4	100

Verpackung: im Tablett
Packaging: in tray
Emballage: en tableau

www.lumberg.com

2411 02
2411 03

USB-2.0-Einbaukupplung Typ B, abgewinkelte Ausführung, für Leiterplatten

- Temperaturbereich** -40 °C/+80 °C
- Werkstoffe**
Kontaktträger PBT GF
Kontaktfeder CuZn, unternickelt und vergoldet
Lötanschluss CuZn, unternickelt und verzinkt
Gehäuse CuZn, unternickelt und verzinkt
- Mechanische Daten**
Steckkraft ≤ 35 N
Ziehkraft ≥ 10 N
Kontaktierung mit USB-Stecker 2431
- Elektrische Daten**
Durchgangswiderstand ≤ 30 mΩ
Bemessungsstrom ≤ 1 A
Bemessungsspannung 30 V AC
Prüfspannung 500 V/60 s
Isolationswiderstand ≥ 100 MΩ

2411 02
2411 03

USB 2.0 chassis socket type B, angular version, for printed circuit boards

- Temperature range** -40 °C/+80 °C
- Materials**
Insulating body PBT GF
Contact spring CuZn, pre-nickelated and gilded
Solder pin CuZn, pre-nickelated and tinned
Shell CuZn, pre-nickelated and tinned
- Mechanical data**
Insertion force ≤ 35 N
Withdrawal force ≥ 10 N
Mating with USB plug 2431
- Electrical data**
Contact resistance ≤ 30 mΩ
Rated current ≤ 1 A
Rated voltage 30 V AC
Test voltage 500 V/60 s
Insulation resistance ≥ 100 MΩ

2411 02
2411 03

Embase femelle USB 2.0 type B, version angulaire, pour cartes imprimées

- Température d'utilisation** -40 °C/+80 °C
- Matériaux**
Corps isolant PBT GF
Ressort de contact CuZn, sous-nickelé et doré
Plot à souder CuZn, sous-nickelé et étamé
Boîtier CuZn, sous-nickelé et étamé
- Caractéristiques mécaniques**
Force d'insertion ≤ 35 N
Force de séparation ≥ 10 N
Raccordement avec connecteur mâle USB 2431
- Caractéristiques électriques**
Résistance de contact ≤ 30 mΩ
Courant assigné ≤ 1 A
Tension assignée 30 V AC
Tension d'essai 500 V/60 s
Résistance d'isolement ≥ 100 MΩ